









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD30N03S2L07ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD30N03S2L07ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD30N03S2L07ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 85µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD30N03S2L07ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD30N03S2L07ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD30N03S2L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD30N03S2L07ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD30N03S2L10ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N03S2L-20 INFINEO IPD30N03S2L-20 INFINEO</p>	 <p>IPD30N03S2L20ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N03S2L-10 Infineon IPD30N03S2L-10 Infineon</p>
 <p>IPD30N03S4L-14 INFINEO IPD30N03S4L-14 INFINEO</p>	 <p>IPD30N03S2L-10G Infineon Infineon TO-252</p>	 <p>IPD30N03S4L09ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p>IPD30N03S2L-08 Infineon IPD30N03S2L-08 Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD30N03S2L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD30N03S2L07ATMA1 Datenblatt	IPD30N03S2L07ATMA1-Datenblätter	IPD30N03S2L07ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD30N03S2L07ATMA1
IPD30N03S2L07ATMA1 Electronic	IPD30N03S2L07ATMA1-Komponenten	IPD30N03S2L07ATMA1-Verteiler	IPD30N03S2L07ATMA1-Bild	IPD30N03S2L07ATMA1-Teil
IPD30N03S2L07ATMA1 Preis	IPD30N03S2L07ATMA1 Hersteller	IPD30N03S2L07ATMA1 Bild	IPD30N03S2L07ATMA1 Aktie	IPD30N03S2L07ATMA1 Inventar
IPD30N03S2L07ATMA1 Neu	IPD30N03S2L07ATMA1 Original	IPD30N03S2L07ATMA1 garantiert	IPD30N03S2L07ATMA1 RFQ	IPD30N03S2L07ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited